

פיזיקה 2 חשמל ומגנטיות

פרק 8 - חומרים דיאלקטריים

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגילים בסיסיים.....1
2. תרגול נוסף.....4

הרצאות ותרגילים בסיסיים:

רקע:

חומר דיאלקטרי - חומר שמכיל דיפולים

במצב רגיל כל דיפול לכיוון שונה והשדה הממוצע בחומר הוא אפס.
כשמכנסים את החומר לשדה חצוני הדיפולים מתיישרים ויוצרים שדה מנוגד לשדה החיצוני.

נסמן:

$\vec{E}_0$ או $\vec{E}_{free}$ - השדה החיצוני

$\vec{E}$ - השדה הכולל

ϵ_r או κ - מקדם דיאלקטרי של החומר -תכונה של החומר בדר"כ קבוע וידוע.

$$\epsilon_r > 1$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

השדה בתוך החומר יהיה:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

(בהנחה שהחומר לינארי ואיזוטרופי).

σ_i - צפיפות מטען מושרית/קשורה. צפיפות מטען שנוצרת על שפת החומר הדיאלקטרי מהקיטוב של הדיפולים.

σ_{free} - צפיפות המטען שיוצרת את השדה החיצוני.

$$\sigma_{free} = \epsilon_0 \Delta E_{0\perp}$$

σ_T - צפיפות המטען הכוללת.

$$\sigma_T = \epsilon_0 \Delta E_{\perp}$$

$$\sigma_i = \sigma_T - \sigma_{free}$$

$\vec{P}$ - וקטור הפולריזציה. צפיפות הדיפולים ליחידת נפח.

$$\vec{P} = N\vec{p}_1$$

$\vec{p}_1$ - מומנט הדיפול של דיפול יחיד בחומר.

N - מספר הדיפולים ביחידת נפח. יחידות של $\left[\frac{1}{m^3}\right]$.

מומנט הדיפול הכולל בחומר :

$$\vec{p} = \int \vec{P} dV$$

על השפה :

$$\sigma_i \equiv \sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

כאשר $\hat{n}$ הוא וקטור יחידה המאונך לשפה כלפי חוץ מהגוף.

אם $\vec{P}$ לא אחיד אז יש גם צפיפות מטען מושרית נפחית בתוך החומר :

$$\rho_i \equiv \rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

וקטור העתקה :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f \Leftrightarrow \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{inf}$$

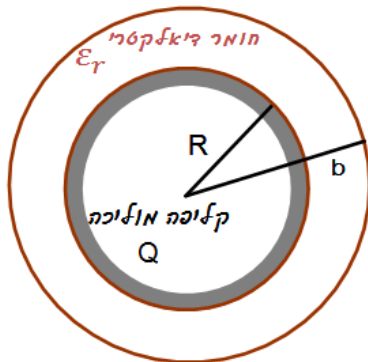
בחומרים לינאריים :

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

חומר איזוטרופי :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}_0$$

שאלות:



- (1) חומר דיאלקטרי מסביב לקליפה מוליכה
 קליפה מוליכה (דקה) ברדיוס R טעונה במטען Q.
 מסביב לקליפה נמצאת קליפה נוספת עבה עם רדיוס פנימי R ורדיוס חיצוני b.
 מצא את השדה בכל המרחב ואת התפלגות המטען המושרית (קשורה).

תשובות סופיות:

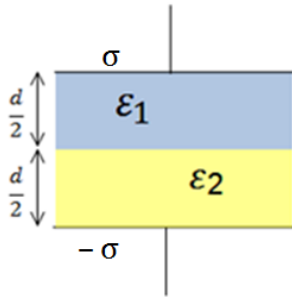
$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{kQ}{\epsilon_r r^2} \hat{r} & R < r < b \\ \frac{kQ}{r^2} & b < r \end{cases} \quad (1) \quad \text{השדה במרחב:}$$

$$\sigma_i(b) = \epsilon_0 \left(\frac{kQ}{b^2} - \frac{kQ}{\epsilon_r b^2} \right), \quad \sigma_i(R) = \frac{\epsilon_0 kQ}{R^2} \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right) \quad \text{התפלגות המטען המושרית:}$$

תרגול נוסף:

שאלות:

(1) חומר דיאלקטרי מפוצל בין שני לוחות



שני לוחות אינסופיים נמצאים במרחק d ביניהם,

הלוח העליון טעון σ והלוח התחתון טעון $-\sigma$.

בין הלוחות ישנם שני סוגים של חומרים דיאלקטריים ליניאריים כפי שנראה בציור.

נתון המקדם הדיאלקטרי של כל חומר ϵ_1 ו- ϵ_2 .

א. מצאו את וקטור העתקה D בכל אחד מהחומרים.

ב. מצאו את השדה החשמלי בכל מקום בין הלוחות.

ג. מצאו את הפולריזציה P בכל אחד מהחומרים.

ד. מצאו את הפרש הפוטנציאל בין הלוחות.

ה. מצאו את גודל ומיקום המטען הקשור בחומרים הדיאלקטריים.

ו. מצאו שוב את השדה בכל המרחב ע"י שימוש במטענים הקשורים והחופשיים.

(2) כדור דיאלקטרי טעון

כדור ברדיוס R מורכב מחומר דיאלקטרי ליניארי בעל קבוע דיאלקטרי אחיד ϵ_r .

בתוך החומר הדיאלקטרי ישנה צפיפות של מטען חופשי (בנוסף לחומר הדיאלקטרי

עצמו) מפוזרת באופן אחיד ושווה ל- ρ .

מצאו את השדה בכל המרחק. (רמז: מצאו קודם כל את D).

(3) כדור מבודד וקליפה מוליכה

כדור מבודד ברדיוס R טעון בצפיפות מטען משתנה

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{R}$$

מסביב לכדור ישנה קליפה מבודדת עבה בעלת

רדיוס פנימי R ורדיוס חיצוני $2R$.

הקליפה עשויה מחומר דיאלקטרי עם מקדם

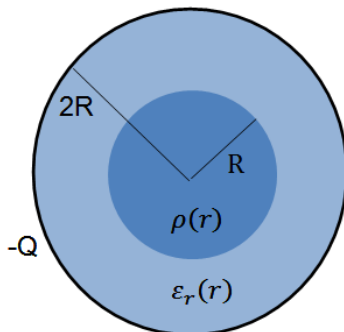
$$\epsilon_r(r) = 1 + \frac{r}{R}$$

מסביב לקליפה הדיאלקטרית ישנה קליפה מוליכה

דקה ברדיוס $2R$ הטעונה במטען כולל $-EQ$.

א. מצא את וקטור העתקה $\vec{D}$ בין כל המרחב.

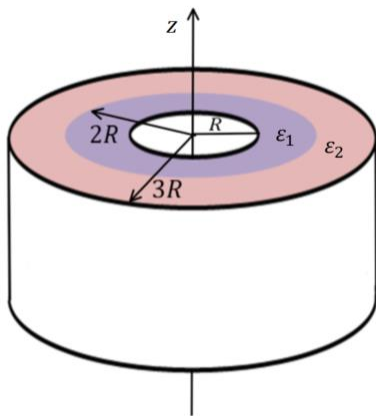
ב. מצא את השדה החשמלי בכל המרחב.



- ג. מהי צפיפות המטען המושרה (או קשור) בתוך החומר הדיאלקטרי (משטחית ונפחית)?
- ד. מצא באמצעות סכימה מפורשת על צפיפות המטען המושרה, את סך המטען המושרה.

(4) חישוב קיבול דרך אנרגיה

- קבל גלילי מורכב משתי קליפות גליליות ברדיוסים R ו- $3R$, ובאורך $L \gg 3R$. ממלאים את הקבל (המרווח בין הקליפות) בחומרים דיאלקטריים. חומר בעל מקדם ϵ_1 ממלא את התווך בין R ל- $2R$ וחומר בעל מקדם ϵ_2 את התווך בין $2R$ ל- $3R$. טוענים את הקליפה הפנימית במטען Q ואת החיצונית במטען $-Q$.
- א. מהי צפיפות האנרגיה בתוך הקבל כתלות במרחק ממרכז הקבל?
- ב. מהי האנרגיה האגורה בקבל?
- ג. חשבו את הקיבול של הקבל מתוך סעיף ב'.
- ד. ניתן להתייחס לקבל כאל שני קבלים המלאים כל אחד בחומר דיאלקטרי שונה. האם הקבלים מחוברים בטור או במקביל? חשב את הקיבול של כל קבל.



תשובות סופיות:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma \hat{z}}{\epsilon_1} & 0 < z < \frac{d}{2} \\ \frac{\sigma \hat{z}}{\epsilon_2} & \frac{d}{2} < z < d \end{cases} \quad \text{ב.} \quad \vec{D} = \sigma \hat{z} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$V = -\frac{d}{2} \sigma \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) \quad \text{ד.} \quad \vec{p} = \begin{cases} \left(\sigma - \frac{\epsilon_0 \sigma}{\epsilon_1} \right) \hat{z} & 0 < z < \frac{d}{2} \\ \left(\sigma - \frac{\epsilon_0 \sigma}{\epsilon_2} \right) \hat{z} & \frac{d}{2} < z < d \end{cases} \quad \text{ג.}$$

$$\sigma_b(z=0) = \sigma \left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon_1} - 1 \right), \quad \sigma_b \left(z = \frac{d}{2} \right) = \epsilon_0 \sigma \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right), \quad \sigma_b(z=d) = \sigma \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2} \right) \quad \text{ה.}$$

$$E_T = \frac{\sigma}{\epsilon_1} \hat{z} \quad \text{ו.}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_r \epsilon_0} & r < R \\ \frac{k\rho 4\pi R^3}{3r^2} & r > R \end{cases} \quad (2)$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho_0 r^2}{4R\epsilon_0} \hat{r} & r < R \\ \frac{\rho_0 R^3 \hat{r}}{4r^2 \epsilon_0 \left(\frac{r}{R} \right)} & R < r < 2R \quad \text{ב.} \\ \frac{\rho_0 \pi R^3 - Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} & 2R < r \end{cases} \quad \vec{D} = \begin{cases} \frac{\rho_0 r^2}{4r} \hat{r} & r < R \\ \frac{\rho_0 4\pi R^3}{16\pi r^2} \hat{r} & R < r < 2R \quad \text{א.} \\ \frac{\rho_0 \pi R^3 - Q}{4\pi r^2} \hat{r} & 2R < r < \infty \end{cases} \quad (3)$$

$$\text{ז.} \quad \sigma_b(r=2R) = \frac{\rho_0 R^2}{4(2R)(3)}, \quad \sigma_b(r=R) = \frac{-\rho_0 R}{8}, \quad \rho_b = \frac{-\rho_0 R^2}{4r^2 \left(1 + \frac{r}{R} \right)^2} \quad \text{א.}$$

$$U = \frac{Q^2}{4\pi L} \left(\frac{1}{\epsilon_1} \ln 2 + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{3}{2} \right) \quad \text{ב.} \quad u = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(2\pi r L)^2} \begin{cases} \frac{1}{\epsilon_1} & R < r < 2R \\ \frac{1}{\epsilon_2} & 2R < r < 3R \end{cases} \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$c_1 = \frac{2\pi L \epsilon_1}{\ln 2}, \quad c_2 = \frac{2\pi L \epsilon_2}{\ln \frac{3}{2}} \quad \text{ד.} \quad C = \frac{2\pi L}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln 2 + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{3}{2}} \quad \text{ג.}$$